



汕头华汕电子器件有限公司

NPN SILICON TRANSISTOR

HEP41C

对应国外型号
TIP41C

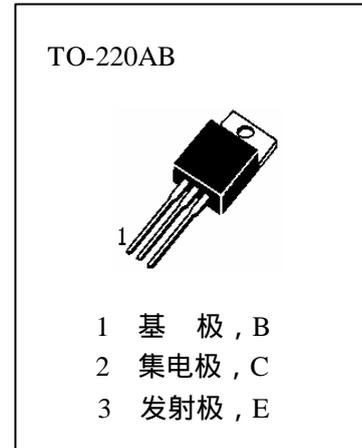
主要用途

音频功率放大。

极限值 ($T_a=25$)

T_{stg}	—— 贮存温度.....	-55~150
T_j	—— 结温.....	150
P_C	—— 集电极功率耗散($T_c=25$).....	65W
P_C	—— 集电极功率耗散($T_A=25$).....	2W
V_{CBO}	—— 集电极—基极电压.....	100V
V_{CEO}	—— 集电极—发射极电压.....	100V
V_{EBO}	—— 发射极—基极电压.....	5V
I_C	—— 集电极电流.....	6A
I_B	—— 基极电流.....	2A

外形图及引脚排列



电参数 ($T_a=25$)

参数符号	符 号 说 明	最小值	典型值	最大值	单 位	测 试 条 件
I_{CEO}	集电极—发射极截止电流			0.7	mA	$V_{CE}=60V, I_B=0$
I_{EBO}	集电极—基极截止电流			1	mA	$V_{EB}=5V, I_C=0$
I_{CES}	集电极—发射极饱和电流			400	μA	$V_{CE}=100V, V_{EB}=0$
HFE(1)	直流电流增益	30				$V_{CE}=4V, I_C=0.3A$
HFE(2)	直流电流增益	15		75		$V_{CE}=4V, I_C=3A$
$V_{CE(sat)}$	集电极—发射极饱和压降			1.5	V	$I_C=6A, I_B=600mA$
$V_{BE(on)}$	基极—发射极导通电压			2.0	V	$V_{CE}=4V, I_C=6A$
BV_{CEO}	集电极—发射极击穿电压	100			V	$I_C=30mA, I_B=0$
f_T	特征频率	3.0			MHz	$V_{CE}=10V, I_C=500mA$ $f=1MHz$



典型特性曲线

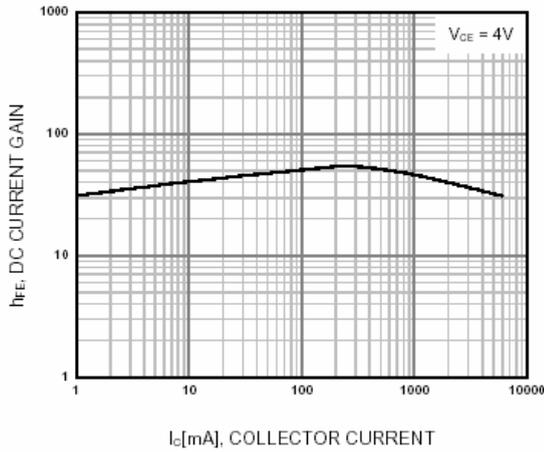


Figure 1. DC current Gain

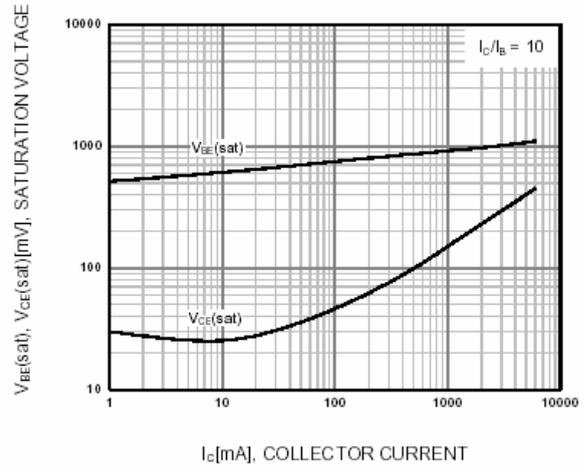


Figure 2. Base-Emitter Saturation Voltage
Collector-Emitter Saturation Voltage

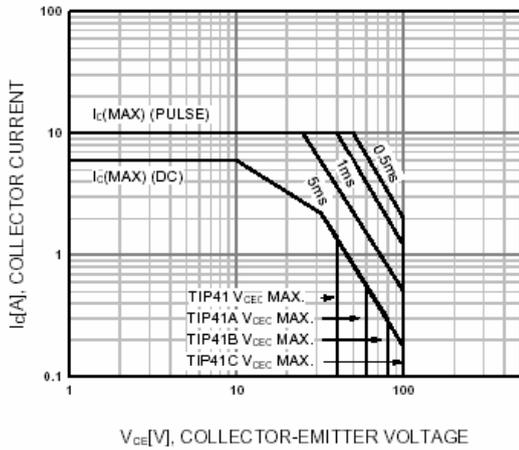


Figure 3. Safe Operating Area

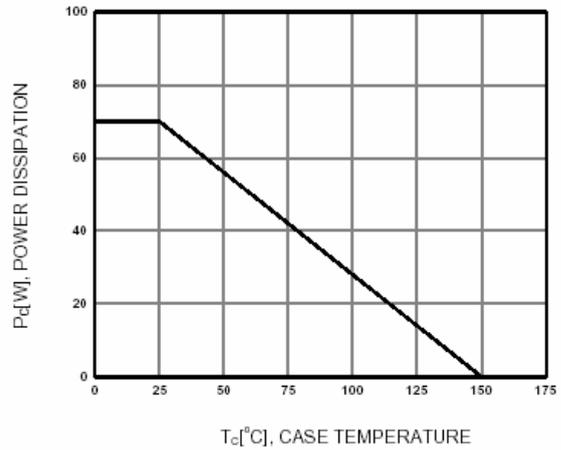


Figure 4. Power Derating